

ПРОГРАММА
XVIII «Координационного научно-технического семинара по
СВЧ технике»
ОАО «НПП «Салют», 04 - 06 сентября 2013 г.
г. Нижний Новгород

Секция 4. Полупроводниковые материалы и особо чистые вещества

Ведущий секции - Котков Анатолий Павлович,
нач. НПО МЭТ ОАО «НПП «Салют», тел (831) 466-34-90, 466-81-56

04 сентября 15-00 ÷ 19-30 (первое заседание секции - малый зал 2)

4.1 РАЗРАБОТКА ПРОЦЕССА СИНТЕЗА МОНОСИЛАНА РАЗЛОЖЕНИЕМ СИЛИЦИДА МАГНИЯ

Д.Ф. Архипцев, А.П. Котков, Н.Д. Гришнова, А.И. Скосырев, О.С. Аношин, Н.В. Гладков
ОАО «НПП «Салют», Нижний Новгород

4.2. ИЗГОТОВЛЕНИЕ СТРУКТУР GaAs/Cr В ЕДИНОМ ПРОЦЕССЕ МЕТАЛЛООРГАНИЧЕСКОЙ ГАЗОФАЗНОЙ ЭПИТАКСИИ

Н.В. Востоков, В.М. Данильцев, Е.В. Демидов, М.Н. Дроздов,
А.В. Мурель, А.И. Охапкин, О.И. Хрыкин, П.А. Юнин, В.И. Шашкин
ИФМ РАН г. Н.Новгород

4.3. ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ ИСТОЧНИКОВ ФОНОВОЙ ПРИМЕСИ НА ЭЛЕКТРОФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА СЛОЕВ InGaAs /InP, ПОЛУЧЕННЫХ МЕТОДОМ МОС-ГИДРИДНОЙ ЭПИТАКСИИ

П.В. Горлачук, Ю.Л. Рябоштан, И.В. Яроцкая, М.А. Ладугин, А.А. Мармалюк
ООО «Сигм плюс», г. Москва

4.4 ВЫРАЩИВАНИЕ СТРУКТУР GaAs и InP с НИЗКИМ УРОВНЕМ ФОНОВОГО ЛЕГИРОВАНИЯ МЕТОДОМ МОС-ГИДРИДНОЙ ЭПИТАКСИИ ПРИ ПОНИЖЕННОМ ДАВЛЕНИИ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ СВЧ ДИОДОВ ШОТТКИ И МИС

Н.С. Крицкий, Г.В. Медведев, М.В. Ревин, Д.С. Смотровин, А.А. Бирюков, В.А. Иванов, А.П. Котков, А.М. Зыков, Ю.И. Чеченин, Д.И. Дюков
ОАО «НПП «Салют», г. Н.Новгород

4.5. ЗАВИСИМОСТЬ ПАРАМЕТРОВ ГЕТЕРОСТРУКТУР НА ОСНОВЕ GaN ОТ КАЧЕСТВА ИСХОДНЫХ КОМПОНЕНТОВ В УСЛОВИЯХ МОС-ГИДРИДНОЙ ЭПИТАКСИИ

В.А. Курешов*, А.В. Мазалов*, Д.Р. Сабитов*, А.А. Падалица*, А.А. Мармалюк*²

*ООО «Сигм Плюс», г. Москва

² МИТХТ им. М.В. Ломоносова, г. Москва

4.6. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ ПО ПОЛУЧЕНИЮ ВЫСОКОЧИСТЫХ МЕТАЛЛООРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ ГАЛЛИЯ, ИНДИЯ, АЛЮМИНИЯ В ОАО «НПП «САЛЮТ»

Ю.Ф. Радьков, Н.В. Свинков, Д.О. Кабанов, Е.С. Ильин, О.А. Викторов, А.П. Котков,
ОАО «НПП «Салют», Н.Новгород

4.7. ПОЛУЧЕНИЕ ВЫСОКОЧИСТОГО ТРЕХХЛОРИСТОГО МЫШЬЯКА

В. И. Родченков, Д. В. Исаев, К. В. Рыбкин, А. А. Медведев, М.М. Лаптева, А. П. Котков,
ОАО «НПП «Салют», г. Н. Новгород

05 сентября 10-00+14-00 (второе заседание секции, малый зал -2)

4.8. ОТРАБОТКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ ПОЛУЧЕНИЯ НИТРИДА ГАЛЛИЯ, ПРИГОДНОГО ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПОДЛОЖЕК

П.М. Романычев, А.П. Котков, Н.Д. Гришнова, В.А. Бастрыкин, А.П. Мажилин,
В.И. Шашкин*, О.И. Хрыкин*, М.Н. Дроздов*,
ОАО «НПП «Салют»
*ИФМ РАН, г. Н.Новгород

4.9. РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗРАБОТКИ ОБОРУДОВАНИЯ И ПРОЦЕССОВ ПОЛУЧЕНИЯ ВЫСОКОЧИСТОГО АММИАКА

А.И. Скосырев, А.П.Котков, Гришнова Н.Д., О.С. Аношин, Н.В. Гладков, Д.Ф. Архипцев
ОАО «НПП «Салют», г. Нижний Новгород

4.10. РАЗРАБОТКА МЕТОДИК АНАЛИЗА ВЫСОКОЧИСТЫХ МЕТАЛЛООРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ ГАЛЛИЯ, ИНДИЯ И АЛЮМИНИЯ В ОАО «НПП «САЛЮТ»

Е.С. Ильин, Ю.Ф. Радьков, Н.В. Свинков, Д.О. Кабанов, О.А. Викторов, А.П. Котков,
ОАО «НПП «Салют», г. Н.Новгород

4.11. ИССЛЕДОВАНИЕ ЭЛЕКТРОФИЗИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ GaAs ЭПИТАКСИАЛЬНЫХ СТРУКТУР

Н.С. Крицкий, Д.С. Смотрин, Г.В. Медведев, В.А. Иванов, Ю.И. Чеченин, Д.И. Дюков,
А.П. Котков, Е.А. Тарасова*, А.Ю. Чурин*, С.В. Оболенский*, М.Н. Дроздов**,
А.В. Мурель**, О.И. Хрыкин**, В.И. Шашкин**
ОАО «НПП САЛЮТ», г. Н. Новгород,
*ННГУ им. Н.И.Лобачевского, г. Н. Новгород.
**ИФМ РАН, г.Н Новгород

4.12. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС ПОЛУЧЕНИЯ ВЫСОКОЧИСТОГО ТРИМЕТИЛГАЛЛИЯ ДЛЯ МИКРОЭЛЕКТРОНИКИ

Н.В. Свинков, Ю.Ф. Радьков, Д.О. Кабанов, Е.С. Ильин, Н.С. Крицкий, О.А. Викторов,
А.П. Котков,
ОАО «НПП «Салют», Н.Новгород

4.13. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ ВЛИЯНИЯ МЕТОДА ПОЛУЧЕНИЯ АРСИНА И ТРИМЕТИЛГАЛЛИЯ НА ЭЛЕКТРОФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭПИТАКСИАЛЬНЫХ СЛОЁВ GaAs

А.П.Котков, М.В. Ревин, В.А. Иванов, Н.С. Крицкий, Г.В. Медведев
ОАО «НПП «Салют», Н. Новгород

4.14. РАЗРАБОТКА НЕПРЕРЫВНОГО СИНТЕЗА АРСИНА ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИМ МЕТОДОМ.

А.А.Урядов, А.П. Котков, Д.М. Полежаев, Г.В. Пушкарев, Г.Г. Петухов, С.В. Ермолаев,
М.В. Ревин,
ОАО «НПП «Салют», Н.Новгород